



SLS SEMICONDUCTOR (SHENZHEN) CO.,LTD.

**SOT-23 封装半导体场效应管/SOT-23 Plastic-Encapsulate MOSFETS**

**SLS3400** (N-Channel Enhancement mode Field Effect Transistor)

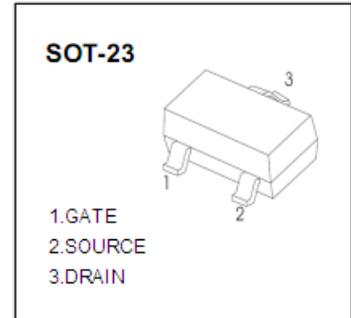
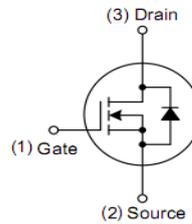
**印章/MARKING: A09T**

**特点/Features :**

- 1、 电流能力强 ;
- 2、 导通电阻低 ;

**用途/Applications :**

用于一般开关和低压电源电路。



**极限参数/Absolute maximum ratings(Ta=25°C)**

参数/Parameter	符号/ Symbol	数值/Value	单位/Unit
漏极-源极电压/Drain-Source Voltage	$V_{DS}$	30	V
栅极-源极电压/Gate-Source Voltage	$V_{GS}$	$\pm 12$	V
漏极电流 (持续) /Continuous Drain Current	$I_D$	5.8	A
耗散功率/Power Dissipation	$P_D$	0.35	W
热阻/ Thermal Resistance Junction to Ambient	$R_{\theta JA}$	350	$^{\circ}C/mW$
结温/Junction Temperature	$T_j$	150	$^{\circ}C$
储存温度/Storage Temperature	$T_{stg}$	-55~150	$^{\circ}C$

**电性能参数/Electrical characteristics (Ta=25°C)**

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
静态/Static Characteristics						
源极-漏极击穿电压	$V_{BR(DSS)}$	$V_{GS}=0V, I_D=250 \mu A$	30			V
栅极开启电压	$V_{GS(th)}$	$I_D=250 \mu A, V_{GS}=V_{DS}$	0.7		1.4	V
栅极漏电流	$I_{GSS}$	$V_{GS}=\pm 12V, V_{DS}=0V$			$\pm 100$	nA
零栅压漏极电流	$I_{DSS}$	$V_{GS}=0V, V_{DS}=24V$			1	$\mu A$
漏极源极导通电阻 <sup>③</sup>	$R_{DS(on)}$	$V_{GS}=10V, I_D=5.8A$			35	m $\Omega$
		$V_{GS}=4.5V, I_D=5A$			40	
		$V_{GS}=2.5V, I_D=4A$			52	
正向跨导 <sup>①</sup>	$g_{fs}$	$V_{DS}=5V, I_D=5A$	8			S
动态/Dynamic Characteristics						
输入电容 <sup>②</sup>	$C_{iss}$	$V_{DS}=15V, V_{GS}=0V, f=1MHz$			1050	pF
输出电容 <sup>②</sup>	$C_{oss}$				99	
反向传输电容 <sup>②</sup>	$C_{rss}$				77	
栅极电阻	Rg	$V_{DS}=0V, V_{GS}=0V, f=1MHz$			3.6	$\Omega$
开关参数/Switching Characteristics						
开启延时 <sup>②</sup>	$t_{d(on)}$	$V_{DS}=15V, V_{GS}=10V,$ $R_{GEN}=3 \Omega, R_L=2.7 \Omega$			5	ns
上升时间 <sup>②</sup>	$t_r$				7	ns
关闭延时 <sup>②</sup>	$t_{d(off)}$				40	ns
下降延时 <sup>②</sup>	$t_f$				6	ns
漏极-源极二极管参数/Drain-source Body Diode Characteristics						
二极管正向压降 <sup>①</sup>	$V_{SD}$	$I_S=1A, V_{GS}=0V$			1	V

注：① 脉冲测试脉冲宽度 $\leq 300\mu s$ , 占空比 $\leq 2\%$ ;

② 这些参数未通过验证;



### 典型特性曲线图/Typical Characteristics

